



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H2907A

对应国外型号  
KTN2907A

## 主要用途

放大、开关应用。

## 极限值 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

$T_{stg}$ ——贮存温度.....	-55~150
$T_j$ ——结温.....	150
$P_c$ ——集电极耗散功率.....	625 mW
$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压.....	-60V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压.....	-60V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压.....	-5V
$I_C$ ——集电极电流.....	-600mA

## 外形图及引脚排列



## 电参数 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	-60			V	$I_C=-10 \mu\text{A}, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	-60			V	$I_C=-10\text{mA}, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-10 \mu\text{A}, I_C=0$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			-10	nA	$V_{CB}=-50\text{V}, I_E=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	75				$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-0.1\text{mA}$
$H_{FE}(2)$		100		300		$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-150\text{mA}$
$H_{FE}(3)$		50				$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-500\text{mA}$
$V_{CE(sat)1}$	集电极—发射极饱和电压			-0.4	V	$I_C=-150\text{mA}, I_B=-15\text{mA}$
$V_{CE(sat)2}$				-1.6	V	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$
$V_{BE(sat)1}$	基极—发射极饱和电压			-1.3	V	$I_C=-150\text{mA}, I_B=-15\text{mA}$
$V_{BE(sat)2}$				-2.6	V	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$
$f_T$	特征频率	200			MHz	$V_{CE}=-20\text{V}, I_C=-50\text{mA}, f=100\text{MHz}$
$C_{ob}$	共基极输出电容			8	pF	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$
$t_{on}$	导通时间			45	ns	$V_{CC}=-30\text{V},$
$t_d$	延迟时间			10	ns	$I_C=-150\text{mA},$
$t_r$	上升时间			40	ns	$I_{B1}=-15\text{mA}$
$t_{off}$	关闭时间			100	ns	$V_{CC}=-6\text{V},$
$t_{stg}$	贮存时间			80	ns	$I_C=-150\text{mA},$
$t_f$	下降时间			30	ns	$I_{B1}=I_{B2}=-15\text{mA}$

